## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-169510

(43)Date of publication of application: 14.06,2002

(51)Int.CI.

6096 3/30

(21)Application number: 2001-254850

(71)Applicant:

**SEIKO EPSON CORP** 

(22)Date of filing:

24.08.2001

(72)Inventor:

KASAI TOSHIYUKI

(30)Priority

Priority number: 2000285329

Priority date: 20.09.2000

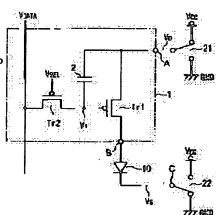
Priority country: JP

## (54) DRIVING CIRCUIT FOR ACTIVE MATRIX DISPLAY AND ELECTRONIC APPARATUS AS WELL AS METHOD OF DRIVING ELECTRONIC DEVICE, AND ELECTRONIC DEVICE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize an organic electroluminescence element driving circuit which realizes reverse biasing with substantially no increase of the electric power consumption and the cost.

SOLUTION: The connecting relation between a power source potential VCC and GND is changed over by changing over switches 21 and 22. The reverse biasing to the organic electroluminescence element 10 is realized without freshly preparing an additional power source, such as a minus power source and the life of the organic electroluminescence element 10 is made longer.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-169510 (P2002-169510A)

(43)公開日 平成14年6月14日(2002.6.14)

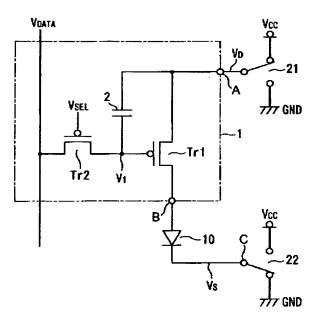
<del></del>		
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I デーマコート*(参考
G 0 9 G 3/30		G 0 9 G 3/30 J 3 K 0 0 7
3/20	6 <b>2 0</b>	3/20 6 2 0 B 5 C 0 8 0
	624	6 2 4 E
	6 7 <b>0</b>	670K
H05B 33/08		H 0 5 B 33/08
	審査請求	未請求 請求項の数11 OL (全 12 頁) <b>最終</b> 頁に
(21)出願番号	特顧2001-254850(P2001-254850)	(71) 出願人 000002369
		セイコーエプソン株式会社
(22)出顧日	平成13年8月24日(2001.8.24)	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
		(72)発明者 河西 利幸
(31)優先権主張番号	特爾2000−285329 (P2000−285329)	長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイ
(32)優先日	平成12年9月20日(2000.9.20)	ーエプソン株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(74)代理人 100095728
		弁理士 上柳 雅誉 (外2名)
		Fターム(参考) 3K007 ABI1 ABI8 BA06 DA01 DB03
		EB00 GA02 GA04
		50080 AA06 BB05 DD29 FF11 JJ03
		JJ04 JJ06 KK07 KK47

## (54) 【発明の名称】 アクティブマトリクス型表示装置の駆動回路及び電子機器及び電子装置の駆動方法及び電子装置

## (57)【要約】

【課題】 消費電力の増加やコストの増大をほとんど伴わずに逆バイアスの印加を実現できる有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路を実現する。

【解決手段】 スイッチ21及び22を切換えることによって、電源電位VccとGNDとの接続関係を切換える。新たにマイナス電源などの追加電源を用意することなく有機エレクトロルミネッセンス素子10への逆バイアス印加を実現し、有機エレクトロルミネッセンス素子10の長寿命化を図る。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 電気光学素子からなる複数の画素がマトリクス状に配列された表示装置をアクティブ駆動する駆動回路であって、

第1の電位を供給する第1の電源線及び前記第1の電位 よりも低い第2の電位を供給する第2の電源線のいずれ か一方に電気的に接続される第1の端子と、

前記第1及び前記第2の電源線のいずれか一方に前記電 気光学素子を介して電気的に接続される第2の端子と、 を含み、

前記電気光学素子が第1の動作状態であるときには、前記第1の端子は前記第1の電源線に電気的に接続され、かつ、前記第2の端子は前記電気光学素子を介して前記第2の電源線に電気的に接続された状態となり、

前記電気光学素子が第2の動作状態であるときには、前記第1の端子は前記第2の電源線に電気的に接続され、かつ、前記第2の端子は前記電気光学素子を介して前記第1の電源線に電気的に接続された状態となるタイミングが少なくともあること、を特徴とするアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路。

【請求項2】 前記電気光学素子の動作状態を制御する ための駆動トランジスタと、

前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷 を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子 への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含 み、

前記容量素子を構成する一方の電極は前記第1の端子に 電気的に接続され、前記容量素子を構成する他方の電極 は前記駆動トランジスタのゲート電極に電気的に接続さ れ

前記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジスタのソース及びドレインを介して電気的に接続されていること、を特徴とする請求項1記載のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路。

【請求項3】 前記電気光学素子の動作状態を制御する ための駆動トランジスタと、

前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含む

前記容量素子を構成する一方の電極は前記容量素子の充電期間にオフ状態になる選択トランジスタを介して前記第1の端子に電気的に接続され、

前記容量素子を構成する他方の電極は前記駆動トランジスタのゲート電極に電気的に接続され、

前記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジスタのソース及びドレイン並びに前記選択トランジスタのソース及びドレインを介して電気的に接続されていること、を特徴とする請求項1記載のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路。

【請求項4】 前記電気光学素子の動作状態を制御する ための駆動トランジスタと、

前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷 を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子 への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含 み、

前記容量素子を構成する一方の電極は前記駆動トランジ スタのゲート電極に電気的に接続され、

前記容量素子を構成する他方の電極はグランドに電気的 に接続され、

前記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジスタのソース及びドレインを介して電気的に接続されていること、を特徴とする請求項1記載のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路。

【請求項5】 請求項1乃至4のいずれかに記載のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路であって、前記電気光学素子が有機エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路。

【請求項6】 請求項1乃至5のいずれかに記載の駆動 回路を備えるアクティブマトリクス型表示装置が実装されてなる電子機器。

【請求項7】 第1の電位を有する第1の電源線と、前記第1の電位より低電位である第2の電位を有する第2の電源線と、前記第1の電源線と前記第2の電源線との間に電気的に配置された電子素子と、を備えた電子装置の駆動方法であって、

前記電子素子の一端を前記第1の電源線に電気的に接続するときは、前記電子素子の他端を前記第2の電源線に 療法

前記電子素子の前記一端を前記第2の電源線に電気的に接続するときは、前記電子素子の前記他端を前記第1の電源線と電気的に接続すること、

を特徴とする電子装置の駆動方法。

【請求項8】 請求項7に記載の電子装置の駆動方法に おいて、前記電子素子は電流により駆動される電流駆動 素子であること、

を特徴とする電子装置の駆動方法。

【請求項9】 第1の電位を有する第1の電源線と、前記第1の電位より低電位である第2の電位を有する第2の電源線と、前記第1の電源線と前記第2の電源線との間に電気的に配置された電子素子と、を備えた電子装置であって、

前記電子素子の一端が前記第1の電源線に電気的に接続 されるときは、前記電子素子の他端が前記第2の電源線 に接続され、

前記電子素子の前記一端が前記第2の電源線に電気的に接続されるときは、前記電子素子の前記他端が前記第1の電源線と電気的に接続されること、

を特徴とする電子装置。

【請求項10】 請求項9に記載の電子装置において、 前記電子素子は、データ信号を供給するデータ線と、走 査信号を供給する走査線との交点に対応して配置された 単位回路内に配置されていること、

を特徴とする電子装置。

【請求項11】 請求項10に記載の電子装置におい て、

前記単位回路は、前記電子素子の導通状態を制御する第 1のトランジスタと、

前記走査線にゲート電極が接続された第2のトランジス タと、

前記第1のトランジスタのゲート電極に接続され、前記 データ線により供給される前記データ信号に対応した電 荷を蓄積する容量素子と、

を含むこと、

を特徴とする電子装置。

【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機エレクトロルミ ネッセンス(Eectro Luminescense)素子(以下、「有機 エレクトロルミネッセンス素子」と称する) などの電気 光学素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置の駆 動回路及び電子機器及び電子装置の駆動方法及び電子装 置に関し、特に電気光学素子の劣化を抑制するために電 気光学素子に対し逆バイアス印加する機能を有した駆動 回路及び電子機器及び電子装置の駆動方法及び電子装置 に関する。

#### [0002]

【従来の技術】電気光学素子の一つである有機エレクト ロルミネッセンス素子からなる複数の画素をマトリクス 30 訳ではなく、これが輝度むら等の要因となることがあ 状に配列することによって表示装置を実現できることが 知られている。有機エレクトロルミネッセンス素子は、 例えばMg:Ag、AL:Li等の金属電極による陰極 と、ITO (Indium Tin Oxide)からなる透明電極に よる陽極との間に、発光層を含む有機積層薄膜を有す構 成をとる。

【0003】有機エレクトロルミネッセンス素子を用い たアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路の一般的 な構成が図8に示されている。同図において、有機エレ クトロルミネッセンス素子は、ダイオード10として表 40 記されている。また駆動回路1は、薄膜トランジスタ (TFT)からなる二つのトランジスタTrl, Tr2 と、電荷を蓄積する容量素子2とから構成されている。 【0004】トランジスタTrl及びTr2は共にPチ ヤネル型のTFTであるものとする。同図中の容量素子 2に蓄積された電荷に応じてトランジスタTrlがオン ・オフ制御される。容量素子2への充電は、選択電位V SEL をローレベルにすることでオン状態になったトラン ジスタT r 2を介してデータ線 V DATA により行なわれ る。トランジスタTr1がオンのとき、トランジスタT 50

r 1を介して有機エレクトロルミネッセンス素子10に 電流が流れる。この電流を有機エレクトロルミネッセン ス素子10に流し続けることで有機エレクトロルミネッ センス素子10は継続して発光する。

【0005】図8の回路に関する簡単なタイミングチャ ートが図9に示されている。図9に示されているよう に、データ書込みを行う場合には、選択電位 V SEL をロ ーレベルにすることでトランジスタTr2をオン状態と し、これにより容量素子2を充電する。この充電期間が 同図中の書込期間Twである。この書込期間Twの後、実 際に表示を行う期間となる。この期間においては、容量 素子2に蓄積された電荷によりトランジスタT r 1 がオ ン状態になる。この期間が同図中の表示期間Tuであ る。

【0006】また、図10には、有機エレクトロルミネ ッセンス素子の駆動回路の他の構成が示されている。同 図に示されている駆動回路は、文献「The Impact of Tr ansient Response of Organic Light Organic Light E mitting Diodes on the Design of Active Matrix OLED 75) に記載されている。図10において、Tr1は駆 動トランジスタ、Tr2は充電制御トランジスタ、Tr 3は第1の選択トランジスタ、Tr4は容量素子2の充 電期間にオフ状態になる第2の選択トランジスタであ

【0007】ここでよく知られているようにトランジス タは同一規格のものでも特性にはばらつきがあり、従っ て、トランジスタのゲート電極に同一の電圧を印加した としても必ずしもトランジスタに一定値の電流が流れる る。これに対してこの駆動回路では、電流源4から出力 されるデータ信号に応じた電流量に基づいて容量素子2 に電荷が蓄積される。従って、データに応じた電流量に 基づいて有機エレクトロルミネッセンスの発光状態を制 御できる。

【0008】トランジスタTrl~Tr4はすべてPチ ャネル型MOSトランジスタであり、選択電位Vspl を ローレベルにすることでトランジスタTr2及びTr3 をオン状態にし、電流源4の出力に応じた値の電荷が容 量素子2に蓄積される。そして、選択電位VsELがハイ レベルとなり、Tr2およびTr3がオフ状態となった 後に、この容量素子2に蓄積された電荷によりトランジ スタTrlがオン状態となり、データ保持制御信号Vg によりトランジスタTr4がオン状態になることで有機 エレクトロルミネッセンス素子10に電流が流れる。

【0009】図10の回路に関する簡単なタイミングチ ャートが図11に示されている。図11に示されている ように、電流源4によるデータ書込みを行う場合には、 選択電位Vstlをローレベルにすることにより、トラン ジスタT r 2, T r 3をオン状態にして、容量素子2を 5

充電する。この充電期間が同図中の書込期間 T w である。この書込期間 T w の後、実際に表示を行う期間となる。データ保持制御信号  $V_{gp}$  がローレベルの期間においては、トランジスタ T r 1 がオン状態になり、この期間が表示期間 T H になる。

【0010】図12には有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路のさらに別の構成が示されている。同図に示されている駆動回路は、特開平11-272233号公報に記載されている回路である。同図において、駆動回路は、オン状態になっているときに電源による電流を有機エレクトロルミネッセンス素子10に与える駆動トランジスタTr1と、このトランジスタTr1をオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素子2と、外部信号に応じて容量素子2への充電を制御する充電制御トランジスタTr5とを含んで構成されている。なお、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光させる場合、充電制御トランジスタTr7をオフ状態にするために電位Vrscanをローレベルの状態に保持しておく。これにより、リセット信号Vrstg は出力されない。尚、Tr6は調整用のトランジスタである。

【0011】この駆動回路において、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光させる場合、トランジスタTr5をオン状態にし、データ線VDATAによってトランジスタTr6を介して容量素子2を充電する。この充電レベルに応じてトランジスタTr1のソースードレイン間のコンダクタンスを制御し、有機エレクトロルミネッセンス素子10に電流を流せば良い。すなわち、図13に示されているように、トランジスタTr5をオン状態にするために電位Vscanをハイレベルの状態にすれば、トランジスタTr6を介して容量素子2が充電される。この充電レベルに応じてトランジスタTr1のソースードレイン間のコンダクタンスが制御され、有機エレクトロルミネッセンス素子10に電流が流れることになる。

#### [0012]

【発明が解決しようとする課題】ところで、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスを印加することは、有機エレクトロルミネッセンス素子の長寿命化に有効な手段であることが知られている。この長寿命化については、例えば特開平11-8064号公報に記載されている。

【0013】しかしながら、同公報の方法では、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアス印加を行う場合、新たにマイナス電源などの追加電源を用意し、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスをかけるように制御することが必要になる。

【0014】そこで本発明は、消費電力やコストの増加をほとんど伴わずに有機エレクトロルミネッセンス素子などの電気光学素子に逆バイアスを印加することのできるアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路及び電子機器及び電子装置の駆動方法及び電子装置を提供するこ

とを目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明による第1のアク ティブマトリクス型表示装置の駆動回路は、電気光学素 子からなる複数の画素がマトリクス状に配列された表示 装置をアクティブ駆動する駆動回路であって、第1の電 位を供給する第1の電源線及び前記第1の電位よりも低 い第2の電位を供給する第2の電源線のいずれか一方に 電気的に接続される第1の端子と、前記第1及び前記第 2の電源線のいずれか一方に前記電気光学素子を介して 電気的に接続される第2の端子と、を含み、前記電気光 学素子が第1の動作状態であるときには、前記第1の端 子は前記第1の電源線に電気的に接続され、かつ、前記 第2の端子は前記電気光学素子を介して前記第2の電源 線に電気的に接続された状態となり、前記電気光学素子 が第2の動作状態であるときには、前記第1の端子は前 記第2の電源線に電気的に接続され、かつ、前記第2の 端子は前記電気光学素子を介して前記第1の電源線に電 気的に接続された状態となるタイミングが少なくともあ ること、を特徴とする。

【0016】また本発明による第2のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路は、前記電気光学素子の動作状態を制御するための駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含み、前記容量素子を構成する一方の電極は前記第1の端子に電気的に接続され、前記容量素子を構成する他方の電極は前記駆動トランジスタのゲート電極に電気的に接続され、前記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジスタのソース及びドレインを介して電気的に接続されていること、を特徴とする。

【0017】また本発明による第3のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路は、前記電気光学素子の動作状態を制御するための駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含み、前記容量素子を構成する一方の電極は前記容量素子の充電期間にオフ状態になる選択トランジスタを介して前記第1の端子に電気的に接続され、前記容量素子を構成する他方の電極は前記駆動トランジスタのゲート電極に電気的に接続され、前記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジスタのソース及びドレイン並びに前記選択トランジスタのソース及びドレイン並びに前記選択トランジスタのソース及びドレインを介して電気的に接続されていること、を特徴とする。

【0018】また本発明による第4のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路は、前記電気光学素子の動作状態を制御するための駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する

容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含み、前記容量素子を構成する一方の電極は前記駆動トランジスタのゲート電極に電気的に接続され、前記容量素子を構成する他方の電極はグランドに電気的に接続され、前記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジスタのソース及びドレインを介して電気的に接続されていること、を特徴とする。

【0019】要するに、駆動回路に対する第1電源と第2電源との接続状態をスイッチで切換えているので、電源を追加する必要もなく、消費電力やコストの増加をほとんど伴わずに有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスを印加することができる。この場合、一般的には、第1電源がVccで、第2電源がグランド(GND)であり、もともと用意されている電位を用いる。もっとも、有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させるのに充分な電位差が確保できれば、それらに限定されることはない。

【0020】また本発明の第5のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路は、前記電気光学素子が有機エレ 20クトロルミネッセンス素子であること、を特徴とする。 【0021】また本発明の第1の電子機器は、前記駆動

【0021】また本発明の第1の電子機器は、前記駆動 回路を備えるアクティブマトリクス型表示装置が実装さ れてなる電子機器であること、を特徴とする。

【0022】また本発明の第1の電子装置の駆動方法は、第1の電位を有する第1の電源線と、前記第1の電位を有する第2の電源線と、前記第1の電源線と前記第2の電源線との間に電気的に配置された電子素子と、を備えた電子装置の駆動方法であって、前記電子素子の前記一端を前記第1の電源線に電気的に接続するときは、前記電子素子の前記一端を前記第2の電源線に接続し、前記電子素子の前記一端を前記第2の電源線に電気的に接続するときは、前記電子素子の前記他端を前記第1の電源線と電気的に接続すること、を特徴とする。

【0023】なお、「電気的に配置される」には、必ずしも直接電源線に電子素子が接続されている場合だけでなく、電源線と電子素子との間にトランジスタなどの他の素子が配置される場合も含まれるものとする。また、電子素子としては、例えば、液晶素子、電気泳動素子、エレクトロルミネッセンス素子などであり、また、電圧を印加、もしくは電流を供給することで駆動される素子を意味するものである。

【0024】また本発明の第2の電子装置の駆動方法は、上記電子装置の駆動方法において、前記電子素子は電流により駆動される電流駆動素子であること、を特徴とする。

【0025】すなわち、電子素子が電流駆動素子である場合には、この駆動方法により電子素子には正方向と逆方向の電流が流れることになる。

【0026】また本発明の第1の電子装置は、第1の電位を有する第1の電源線と、前記第1の電位より低電位である第2の電位を有する第2の電源線と、前記第1の電源線と前記第2の電源線との間に電気的に配置された電子素子と、を備えた電子装置であって、前記電子素子の一端が前記第1の電源線に電気的に接続されるときは、前記電子素子の他端が前記第2の電源線に接続され、前記電子素子の前記一端が前記第2の電源線に電気的に接続されるときは、前記電子素子の前記他端が前記第1の電源線と電気的に接続されること、を特徴とす

8

【0027】また、本発明の第2の電子装置は、上記の電子装置において、前記電子素子は、データ信号を供給するデータ線と、走査信号を供給する走査線との交点に対応して配置された単位回路内に配置されていること、を特徴とする。

【0028】また、本発明の第3の電子装置は、上記の電子装置において、前記単位回路は、前記電子素子の導通状態を制御する第1のトランジスタと、前記走査線にゲート電極が接続された第2のトランジスタと、前記第1のトランジスタのゲート電極に接続され、前記データ線により供給される前記データ信号に対応した電荷を蓄積する容量素子と、を含むこと、を特徴とする。

[0029]

る。

【発明の実施の形態】次に、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。なお、以下の説明において参照する各図では、他の図と同等部分は同一符号によって示されている。

【0030】図1は本発明による有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路を示すプロック図である。同図に示されているように、本例の有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路1は、第1の端子Aを有する。第1の端子Aはスイッチ21により、第1の電位(Vα)を供給する第1の電源線、および、第1の電位よりも低い第2の電位(CND)を供給する第2の電源線、および、第1の電位よりも低い第2の電位

(GND)を供給する第2の電源線のいずれか一方に、 電気的に接続可能な構成となっている。

【0031】また、有機エレクトロルミネッセンス素子 駆動回路1は、第2の端子Bを有する。第2の端子Bは 有機エレクトロルミネッセンス素子10を介してスイッ チ22と電気的に接続されている。第2の端子Bは、ス イッチ22により、第1の電位( $V\alpha$ )を供給する第1 の電源線、および、第1の電位よりも低い第2の電位

(GND)を供給する第2の電源線のいずれか一方に、 有機エレクトロルミネッセンス素子10を介して電気的 に接続可能な構成となっている。尚、第1の電位

 $(V_{\alpha})$  は、第2の電位(GND)よりも高い電位であり、例えば10V程度である。

【0032】有機エレクトロルミネッセンス素子10を 発光させる場合(第1の動作状態)、すなわち表示を行 う場合には、スイッチ21を第1の電位(Vc)を供給する第1の電源線側に設定し、スイッチ22を第2の電位(GND)を供給する第2の電源線側に設定すれば良い。このとき、第1の端子Aは第1の電源線と電気的に接続され、第2の端子Bは有機エレクトロルミネッセンス素子10を介して第2の電源線と電気的に接続される。

【0033】一方、有機エレクトロルミネッセンス素子 10を発光させない場合(第2の動作状態)、すなわち 表示を行わない場合には、スイッチ21を第2の電位 (GND) を供給する第2の電源線側に設定し、スイッ チ22を第1の電位 (Vc) を供給する第1の電源線側 に設定すれば良い。このとき、第1の端子Aは第2の電 源線と電気的に接続され、第2の端子Bは有機エレクト ロルミネッセンス素子10を介して第1の電源線と電気 的に接続される。このような電気的接続関係のときに は、端子Bの電位が第1の電位(Va)より大きくなる ことはないので、有機エレクトロルミネッセンス素子1 0に逆バイアスが印加されることになる。但し、上記の ような電気的接続関係を、有機エレクトロルミネッセン 20 ス素子が第2の動作状態である全期間において続ける必 要は無い。有機エレクトロルミネッセンス素子が第2の 動作状態にある期間のうちの少なくとも一部期間におい て、上記のような電気的接続関係を保てれば良い。

【0034】このように、スイッチ21及び22の設定を切換えるだけで、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスを印加することができるのである。そして、この場合、もともと用意されている電源やGNDを利用するため、新たにマイナス電源などの追加電源を用意する必要がないので、消費電力が増加したり、コストの増加を招くことはない。なお、これらのスイッチ21及び22は、トランジスタを組み合わせて簡単に実現できる。

## [0035]

【実施例】図2は、第1の実施例による駆動回路の内部 構成を示すブロック図である。同図においては、前述し た図8の回路構成を駆動回路1としている。すなわち、 駆動回路1は、有機エレクトロルミネッセンス素子10 の動作状態を制御するための駆動トランジスタT r 1 と、このトランジスタTr1をオン状態に保持するため の電荷を蓄積する容量素子2と、外部信号に応じて容量 素子2への充電を制御する充電制御トランジスタT r 2 とを含んで構成されている。そして、駆動回路1におい ては、容量素子2を構成する一方の電極は第1の端子A に電気的に接続され、容量素子2を構成する他方の電極 は駆動トランジスタTrlのゲート電極に電気的に接続 されている。さらに、駆動トランジスタTг1を構成す る一方のソースまたはドレインは第1の端子Aに電気的 に接続され、駆動トランジスタTrlを構成する他方の ソースまたはドレインは第2の端子Bに電気的に接続さ 50 れている。このため、第1の端子Aと第2の端子Bとが 駆動トランジスタTr1のソース及びドレインを介して 電気的に接続されていることになる。

【0036】そして、第1の端子Aと第2の端子Bとの電気的接続状態をスイッチ21及び22によって切換えているのである。すなわち、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光させる場合(第1の動作状態)には、スイッチ21を電源電位 $V\alpha$ 側に設定し、スイッチ22をGND側に設定する。この状態において容量素子2を充電し、トランジスタTr1をオン状態にして有機エレクトロルミネッセンス素子10に電流を流せば良い。

【0037】一方、有機エレクトロルミネッセンス素子 10を発光させない場合(第2の動作状態)には、スイ ッチ21をGND側に設定し、スイッチ22を電源電位 να 側に設定すれば良い。この場合、図3に示されてい るように、選択電位 V SEL を電源電位 Vαに保ってお く。第1の端子Aの電位(V<sub>D</sub>)を電源電位 V α から G N Dに低下させ、この低下後に、第3の端子Cの電位 (Vs) をGNDから電源電位 $V\alpha$  に上昇させる。する と、駆動トランジスタTrlのゲート電位Viは電位Vo の変化に追従して低下する。通常、トランジスタT г 1 のゲート線には配線容量(図示せず)が付加されるが、 その容量の大きさが容量素子2の容量に対して無視でき る程度であれば、第1の端子Aの電位Veが電源電位V α からGNDに変化したときには、トランジスタTr1 のゲート電位 V1 は電源電位 Vα 分だけ低下する。この とき、第2の端子Bの電位は最大でも駆動トランジスタ Tr1のしきい値電圧(Vth)であり、第3の端子C の電位 Vs は電源電位 Vcc になるので、有機エレクトロ ルミネッセンス素子10に逆バイアスが印加されること になる。

【0038】このように、スイッチ21及び22の設定を切換えるだけで、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスを印加することができる。そして、新たにマイナス電源などの追加電源を用意する必要がないので、消費電力が増加したり、コストが大幅に増大することはない。

【0039】図4は、第2の実施例による駆動回路の内部構成を示すブロック図である。同図においては、前述した図10の回路構成を駆動回路1としている。すなわち、駆動回路1は、有機エレクトロルミネッセンス素子10の動作状態を制御するための駆動トランジスタTr1の導通状態を制御するための電荷を蓄積する容量素子2と、外部信号に応じて容量素子2への充電を制御する充電制御トランジスタTr2とを含んで構成されている。そして、駆動回路1においては、容量素子2を構成する一方の電極は第2の選択トランジスタTr4を介して第1の端子Aに電気的に接続され、容量素子2を構成する他方の電極は駆動トラン

ジスタT r 1のゲート電極に電気的に接続されている。 さらに、駆動トランジスタT r 1の一端は第2の選択トランジスタT r 4を介して第1の端子Aに電気的に接続され、駆動トランジスタT r 1の他端は第2の端子Bに電気的に接続されている。このため、第1の端子Aと第2の端子Bとが、駆動トランジスタT r 1及び選択トランジスタT r 4のソース及びドレインを介して電気的に接続されることになる。

【0040】ここでよく知られているようにトランジスタは同一規格のものでも特性にはばらつきがあり、従って、トランジスタのゲート電極に同一の電圧を印加したとしても必ずしもトランジスタに一定値の電流が流れる訳ではなく、これが輝度むら等の要因となることがある。これに対してこの駆動回路では、電流源4から出力されるデータ信号に応じた電流量に基づいて容量素子2に電荷が蓄積される。従って、データに応じた電流量に基づいて有機エレクトロルミネッセンスの発光状態を制御できる。

【0041】この駆動回路において、第1の端子Aと第2の端子Bの電気的接続状態は、スイッチ21及び22によって、電源電位V $\alpha$ 及びGNDに切換えられる。すなわち、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光させる場合には、スイッチ21を電源電位V $\alpha$  側に設定し、スイッチ22をGND側に設定し、さらにトランジスタTr1をオン状態にすると共にトランジスタTr4をオン状態にして、有機エレクトロルミネッセンス素子10に電流を流せば良い。

【0043】ノードDの電位 $V_1$ は、トランジスタTr4が常時オン状態であることから、第1の端子 A の電位 $V_0$ が電源電位 $V_{CC}$ から G N Dに低下したことに追従し $V_0$ が電源電位 $V_{CC}$ から G N Dに低下したことに追従し $V_0$  に低下する。このとき、通常であればトランジスタT $V_0$  に低下する。このとき、通常であればトランジスタT $V_0$  に低下する。このときが容量素子 $V_0$  2の容量の大きさが容量素子 $V_0$  2の容量に対して無視できる程度であれば、ノードEの電位 $V_0$  は、 $V_0$  ( $V_0$  C  $V_0$  C

子10に逆バイアスが印加されることになる。

【0044】このように、スイッチの設定を切換えるだけで、有機エレクトロルミネッセンス素子への逆バイアスの印加が実現できる。そして、新たにマイナス電源などの追加電源を用意する必要がないので、消費電力が増加したり、コストが大幅に増大することはない。

【0045】図6は、第3の実施例による駆動回路の内 部構成を示すブロック図である。同図においては、特開 平11-272233号公報に記載されている回路を駆 動回路1としている。すなわち、駆動回路1は、有機エ レクトロルミネッセンス素子10の動作状態を制御する ための駆動トランジスタTr1と、このトランジスタT rlをオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素 子2と、外部信号に応じて容量素子2の電荷の蓄積状態 を制御する充電制御トランジスタT r 5とを含んで構成 されている。そして、駆動回路」においては、容量素子 2を構成する一方の電極は駆動トランジスタT r 1のゲ ート電極に電気的に接続され、容量素子2を構成する他 方の電極はGNDに電気的に接続されている。さらに、 駆動トランジスタT r 1を構成する一方のソースまたは ドレインは第1の端子Aに電気的に接続され、駆動トラ ンジスタTr1を構成する他方のソースまたはドレイン は第2の端子Bに電気的に接続されている。このため、 第1の端子Aと第2の端子Bとが駆動トランジスタTr 1のソース及びドレインを介して電気的に接続されてい ることになる。尚、同図におけるトランジスタT г 1. Tr6は、Pチャネル型トランジスタ、トランジスタT r5, Tr7はNチャネル型トランジスタである。ま た、ダイオード接続されたトランジスタTr6は、トラ ンジスタTr1のしきい値のばらつきを補償する効果が ある。

【0047】一方、有機エレクトロルミネッセンス素子 10に逆バイアスを印加する場合には、スイッチ21を GND側に設定し、スイッチ22を電源電位 Vcc 側に設定すれば良い。この場合、図7に示されているように、最初に充電制御トランジスタTr5のゲート電極に印加する電位 Vscan を電源電位 Vcc にして容量素子2を充電する。このとき、トランジスタTr1をオンさせるのに充分な電荷を容量素子2に保持させる(充電する)期間

14

だけ電源電位  $V \propto$  にする。データ線 V Data はトランジスタ T r 1 がオンする電位になっていることが必要である。この充電後、スイッチ 2 1 を切換えて第 1 の端子 A の電位 V De V C から G N Dに低下させ、さらにその後スイッチ 2 2 を切換えて第 3 の端子 C の電位 V S E G N Dから V C に上昇させる。なお、T E E 7 はリセット用のトランジスタであり、有機エレクトロルミネッセンス素子 E 1 E Oに逆バイアスをかけているときには、このトランジスタ E E E E C N Dに保持しておく。

【0048】このように、スイッチの設定を切換えるだけで、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスを印加できる。そして、新たにマイナス電源などの追加電源を用意する必要がないので、消費電力が増加したり、コストが大幅に増大することはない。

【0049】なお、以上の各実施例においては、タイミングをずらして2つのスイッチ21及び22を切換えているが、これらスイッチを同時に切換えても良いことは明らかである。切換え制御するための制御信号を、タイミングをずらして2つのスイッチに入力すれば、異なるタイミングで2つのスイッチを切換えることができる。この場合、2つのスイッチそれぞれの制御信号を、異なる段数のバッファを介して入力すれば良い。

【0050】ところで、以上では有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路について説明したが、本発明の適用範囲はこれに限られず、例えば、TFT-LCD、FED(Field Emission Display)、電気泳動素子や電場反転素子、レーザーダイオード、LEDなど、有機エレクトロルミネッセンス素子以外の電気光学素子を用いたアクティブ 30マトリクス型表示装置にも適用することができる。

【0051】つぎに、以上に説明した駆動回路1を備えて構成されるアクティブマトリクス型表示装置を適用した電子機器のいくつかの事例について説明する。図14はこのアクティブマトリクス型表示装置を適用したモバイル型のパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。この図において、パーソナルコンピュータ1100は、キーボード1102を備えた本体部1104と、表示ユニット1106とにより構成され、この表示ユニット1106が前記アクティブマトリクス型表示装置100を備えている。

【0052】また、図15は前述の駆動回路を備えて構成されるアクティブマトリクス型表示装置100をその表示部に適用した携帯電話機の構成を示す斜視図である。この図において、携帯電話機1200は、複数の操作ボタン1202のほか、受話口1204、送話口1206とともに、前記のアクティブマトリクス型表示装置100を備えている。

【0053】また、図16は前述の駆動回路を備えて構成されるアクティブマトリクス型表示装置100をその so

ファインダに適用したディジタルスチルカメラの構成を示す斜視図である。なお、この図には外部機器との接続についても簡易的に示している。ここで通常のカメラは、被写体の光像によりフィルムを感光するのに対し、ディジタルスチルカメラ1300は、被写体の光像をCCD(Charge Coupled Device)などの撮像素子により光電変換して撮像信号を生成する。ディジタルスチルカメラ1300におけるケース1302の背面には、アクティブマトリクス型表示装置100が設けられ、CCDによる撮像信号に基づいて表示を行う構成になっており、アクティブマトリクス型表示装置100は被写体を表示するファインダとして機能する。また、ケース1302の観察側(図においては裏面側)には、光学レンズやCCDなどを含んだ受光ユニット1304が設けられている。

【0054】撮影者が駆動回路に表示された被写体像を確認しシャッタボタン1306を押下すると、その時点におけるCCDの撮像信号が、回路基板1308のメモリに転送・格納される。また、このディジタルスチルカメラ1300にあっては、ケース1302の側面に、ビデオ信号出力端子1312と、データ通信用の入出力端子1314とが設けられている。そして、図に示されるように、前者のビデオ信号出力端子1312にはテレビモニタ1430が、また、後者のデータ通信用の入出力端子1314にはパーソナルコンピュータ1430が、それぞれ必要に応じて接続される。さらに、所定の操作により回路基板1308のメモリに格納された撮像信号が、テレビモニタ1430や、パーソナルコンピュータ1440に出力される構成になっている。

【0055】なお、本発明のアクティブマトリクス型表示装置100が適用される電子機器としては、図14のパーソナルコンピュータや、図15の携帯電話、図16のディジタルスチルカメラの他にも、液晶テレビや、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。そして、これらの各種電子機器の表示部として、前述したアクティブマトリクス型表示装置100が適用可能であることは言うまでもない。

## [0056]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、第1の電位からなる第1の電源と第2の電位からなる第2の電源との接続状態をスイッチで切換えることにより、新たにマイナス電源などの追加電源を用意する必要がなく、消費電力の増加やコストの増大をほとんど伴わずに逆バイアス印加を実現できるという効果がある。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による有機エレクトロルミネッセンス素 子駆動回路の実施の一形態を示すブロック図である。 【図2】本発明による有機エレクトロルミネッセンス素 子駆動回路の第1の実施例を示すブロック図である。

【図3】図2の有機エレクトロルミネッセンス素子駆動 回路の動作を示す波形図である。

【図4】本発明による有機エレクトロルミネッセンス素 子駆動回路の第2の実施例を示すブロック図である。

【図5】図4の回路の動作を示す波形図である。

【図6】本発明による有機エレクトロルミネッセンス素 子駆動回路の第3の実施例を示すブロック図である。

【図7】図6の回路の動作を示す波形図である。

【図8】従来の有機エレクトロルミネッセンス素子駆動 回路の構成例を示すブロック図である。

【図9】図8の回路の動作を示す波形図である。

【図10】従来の有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路の他の構成例を示すブロック図である。

【図11】図10の回路の動作を示す波形図である。

【図12】従来の有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路の他の構成例を示すブロック図である。

【図13】図12の回路の動作を示す波形図である。

【図14】本発明の一実施例による駆動回路を備えたアクティブマトリクス型表示装置を、モバイル型のパーソナルコンピュータに適用した場合の一例を示す図である。

16

【図15】本発明の一実施例による駆動回路を備えたアクティブマトリクス型表示装置を、携帯電話機の表示部に適用した場合の一例を示す図である。

【図16】本発明の一実施例による駆動回路を備えたアクティブマトリクス型表示装置を、ファインダ部分に適用したディジタルスチルカメラの斜視図を示す図である。

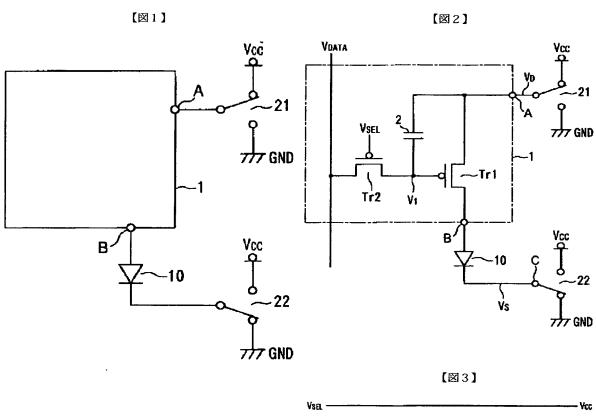
## 【符号の説明】

- 1 駆動回路
- 2 容量素子
- 4 電流源

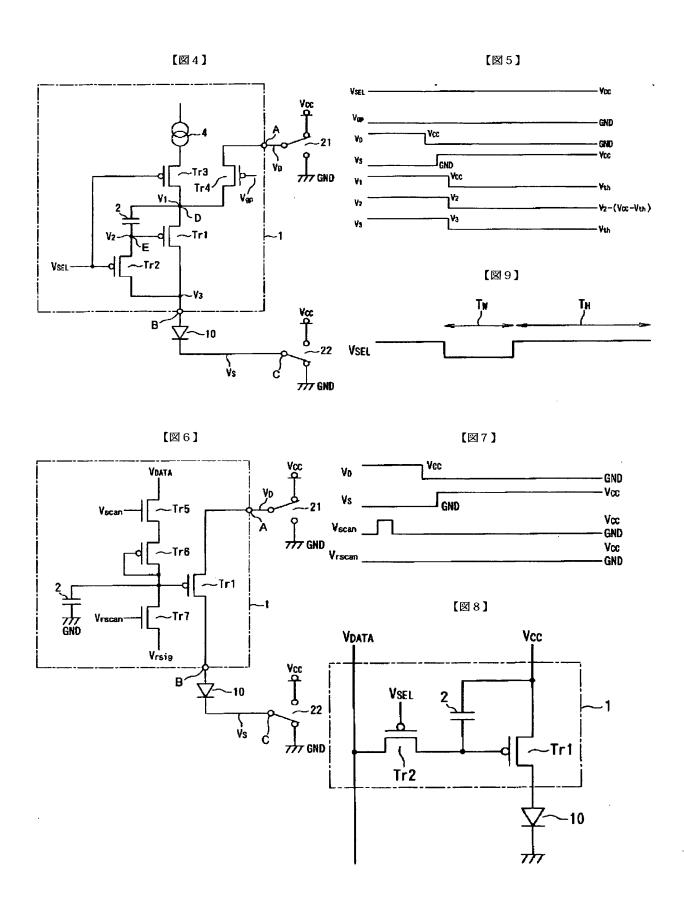
10 有機エレクトロルミネッセンス素子

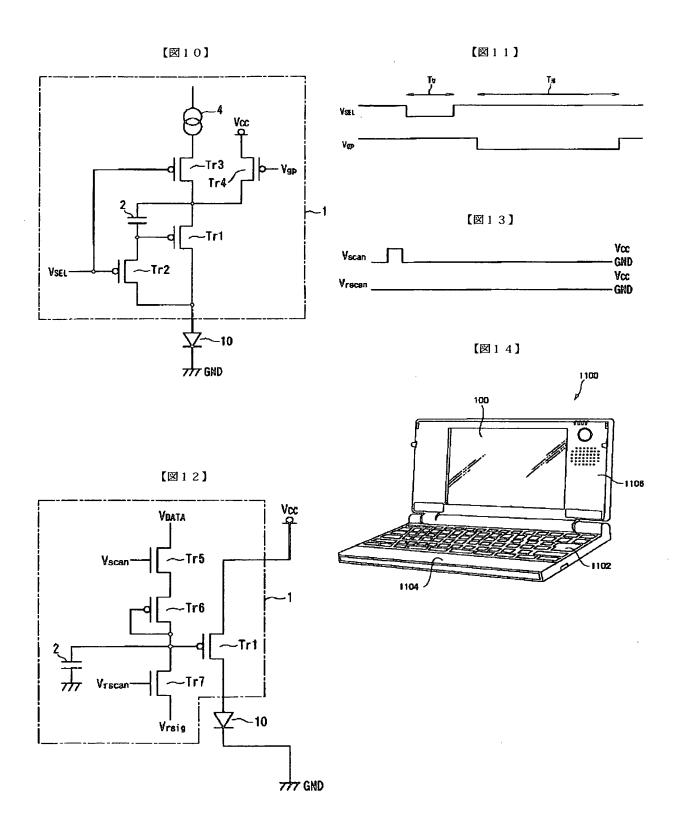
21, 22 スイッチ

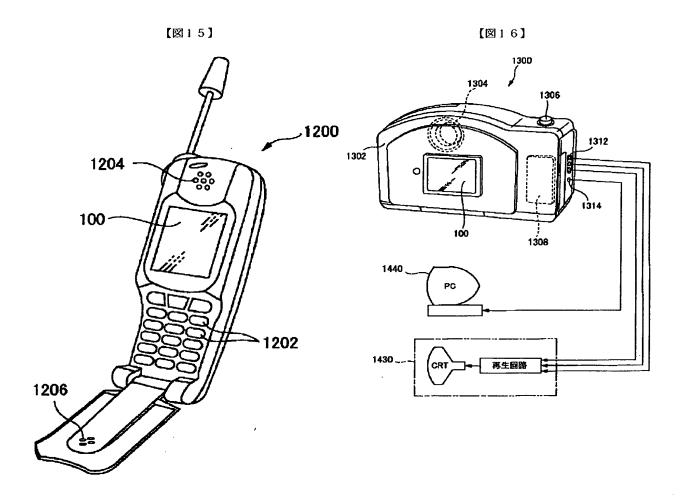
Tr1~Tr7 トランジスタ



Vset — Vcc Vcc GND Vcc GND Vcc V1 V1 V1 -Vcc







フロントページの続き

(51) Int.C1.<sup>7</sup> H O 5 B 33/14 識別記号

F I H O 5 B 33/14 テーマコード(参考)